



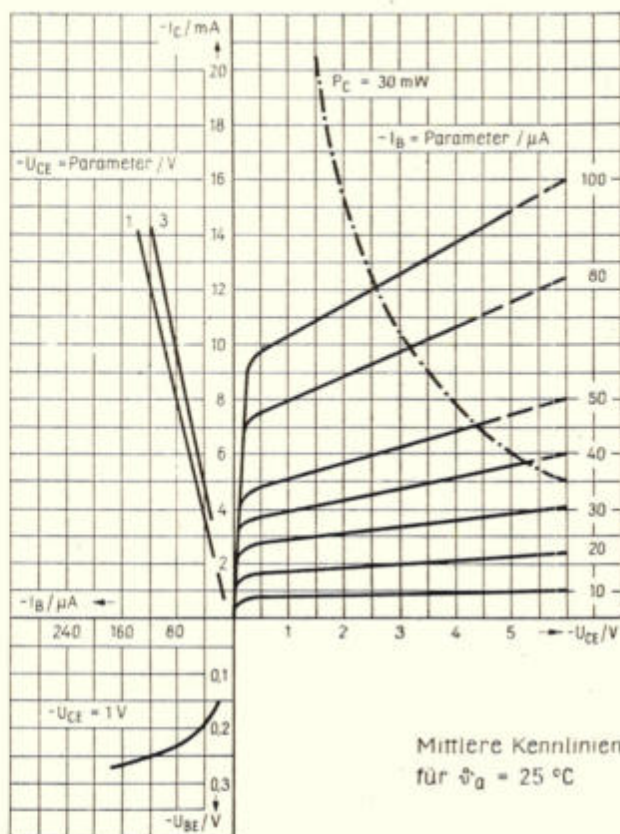
Der HF-Transistor GF 105 (alte Bezeichnung OC 872) ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in der Bauform A 1 (entspricht $\approx$ TO-18-Gehäuse). Der Einsatz ist vornehmlich in Misch- und Oszillatorstufen im Mittel- und Langwellenbereich.

Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25^\circ\text{C} - 5\text{ grd}$)

Kollektorruhestrome

$$\begin{aligned} -I_{CBO} &= 1,5 \leq 10 \mu\text{A} && \text{bei } -U_{CB} = 6 \text{ V} \\ -I_{CBO} &= 50 \leq 500 \mu\text{A} && \text{bei } -U_{CB} = 25 \text{ V} \\ -I_{CEO} &= 200 \leq 800 \mu\text{A} && \text{bei } -U_{CE} = 6 \text{ V} \end{aligned}$$

Emitterruhestrom $-I_{EBO} = 50 \leq 500 \mu\text{A}$ bei $-U_{EB} = 15 \text{ V}$



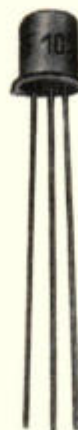
Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Grenzfrequenz in Basisschaltung

$$\begin{aligned} f_{h21b} &= 10,5 \geq 7 \text{ MHz} \\ \text{bei } -U_{CE} &= 6 \text{ V} && -I_C = 0,5 \text{ mA} \\ f_M &= 7 \text{ MHz} && f_o = 0,1 \text{ MHz} \end{aligned}$$

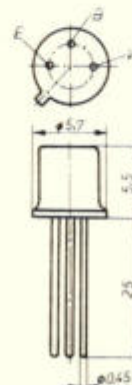
Rauschmaß in Mischschaltung bis 2 MHz

$$\begin{aligned} F &= 11 \leq 20 \text{ dB} \\ (\text{bei } -U_{CE} &= 6 \text{ V} && -I_C = 0,5 \text{ mA} && R_g = 1 \text{ k}\Omega \\ f_M &= 2 \text{ MHz}) \end{aligned}$$



Abmessungen

Bauform A 1 nach TGL 11811
($\approx$ TO 18)



Masse 0,4 g

Vierpolwerte in Emitterschaltung

(bei $U_{CE} = 6 \text{ V}$ $I_C = 0,5 \text{ mA}$ $f_M = 2 \text{ MHz}$)

$$g_{11e} = 0,7 \leq 3,3 \text{ mS}$$

$$c_{11e} = 110 \leq 250 \text{ pF}$$

$$g_{12e} = 2 \leq 5 \mu\text{S}$$

$$c_{12e} = 7 \leq 14 \text{ pF}$$

$$|Y_{21e}| = 16 \geq 10 \text{ mS}$$

$$g_{22e} = 130 \leq 250 \mu\text{S}$$

$$c_{22e} = 29 \leq 35 \text{ pF}$$

$$h_{21e} = 110 \geq 20 \quad (\text{bei } f_M = 1 \text{ kHz})$$

Wärmewiderstand

$$R_{th} \leq 1 \frac{\text{grd}}{\text{mW}}$$

Grenzwerte (für $\vartheta_a = 45^\circ\text{C}$)

$$-U_{CBO} = 15 \text{ V}$$

$$-U_{EBO} = 10 \text{ V}$$

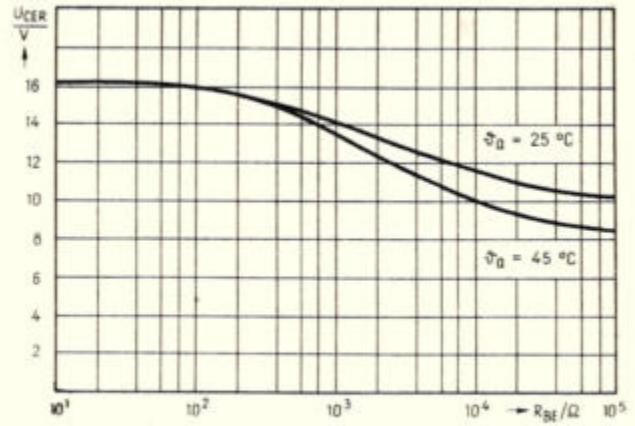
$$\vartheta_j = 75^\circ\text{C}$$

$$\vartheta_a = 65^\circ\text{C}$$

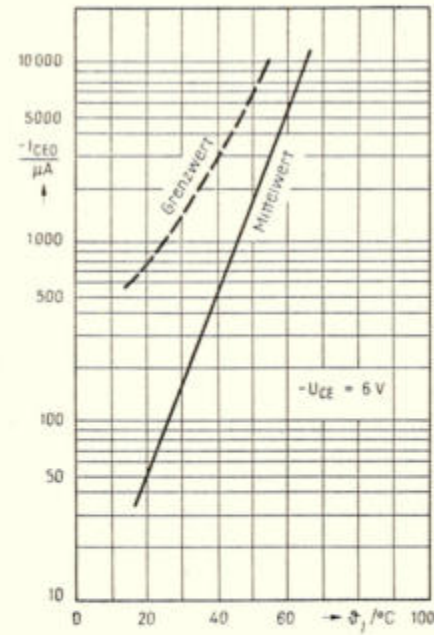
$$-I_C = 15 \text{ mA}$$

$$I_E = 20 \text{ mA}$$

$$-I_B = 5 \text{ mA}$$

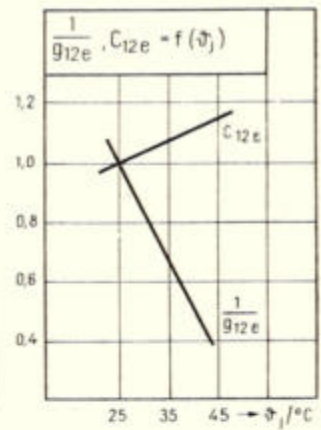
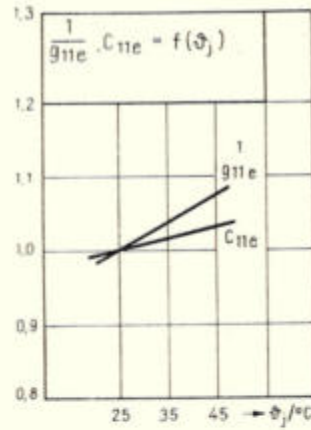
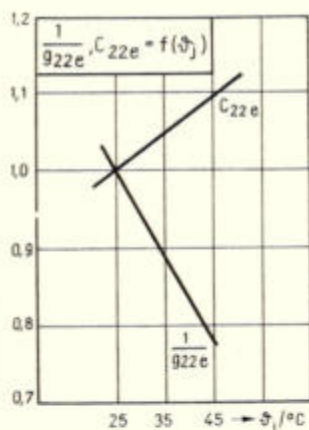
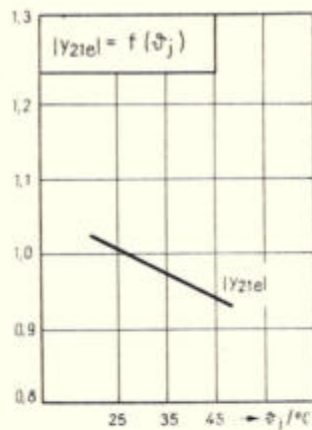


Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basis-emitterwiderstandes



Kollektorruhestrom als Funktion der Sperrschichttemperatur

Temperaturabhängigkeit der Parameter:



Bestellbezeichnung für einen Transistor: **Transistor GF 105**